

桐山製作所 昇華精製装置

(特許出願済)

〈特長〉

1. 比較的大量処理に適しています。
2. 連続・半連続の処理も可能です。
3. 昇華物質のみを、無塵で取り出すこともできます。

(用途)

EL. フォトレジスト等、
半導体材料の精製

昇華装置運転操作

※左画像番号参照

- 1) 昇華槽②に試料を仕込み、ジャケットに熱媒を通す。
- 2) 析出槽③の外部ジャケットに熱媒を通す。
- 3) 析出槽内に設置した析出管④の内部に冷媒を通す。
- 4) 排気口⑤から系内を真空にする。
- 5) 吸気口①から不活性ガス (N₂ ガス) を少量吸入しながら試料中の目的物を昇華させ、析出管の外周に結晶を析出させる。
- 6) 結晶析出が終了したら析出管内の冷媒を熱媒に替えて、付着した結晶を受器⑥に落とし回収される。



装置写真 (全体)



昇華外壁部 (針状結晶)

有限会社桐山製作所

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 2-31-11

URL <http://kiryama.co.jp>

e-mail : info@kiryama.co.jp

TEL 03(3802)0005(代)

FAX03(3801)1170

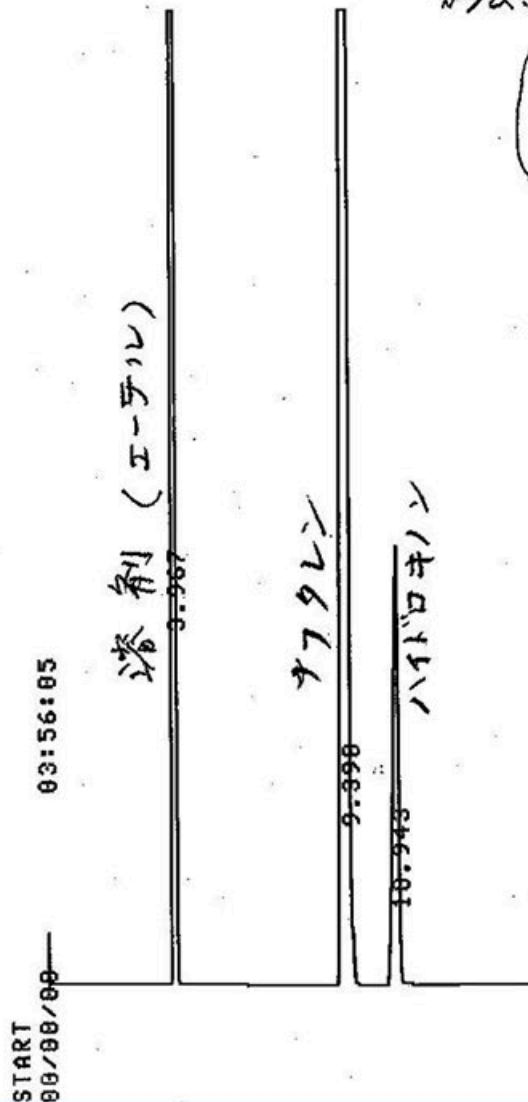
応用例

GLチャート

原料(ナフタレン)

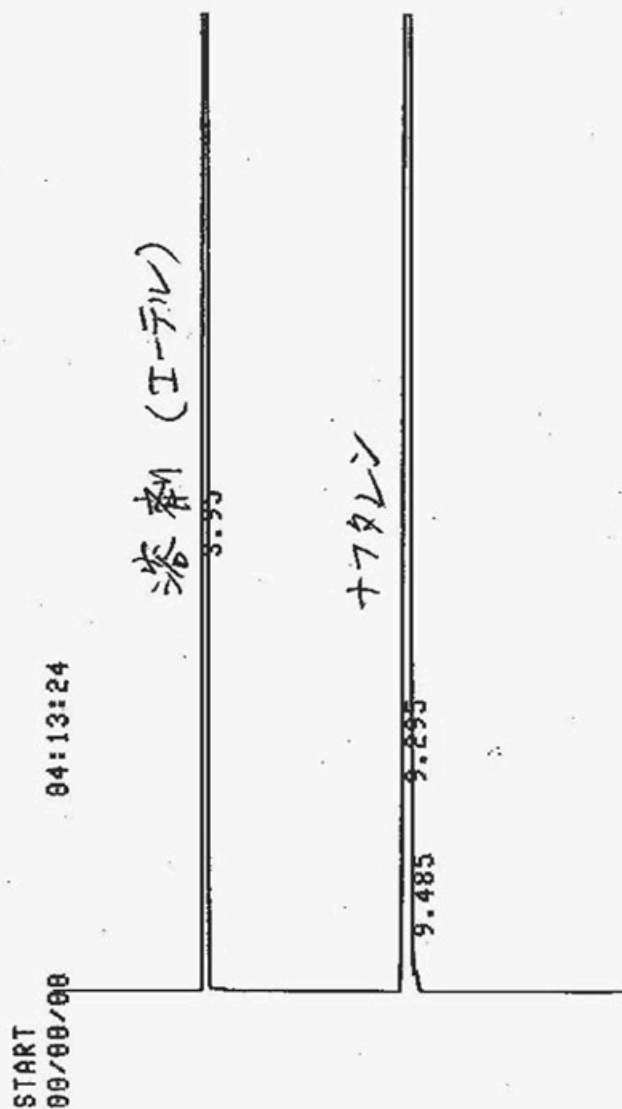
原料混合物

GC測定条件
 カラム: 非極性キャピラリーカラム
 0.25mmφ×30m
 注入温度 150°C
 カラム入口温度 150°C
 オーブン温度 200°C
 検出器 250°C



PKNO	TIME	AREA	MK	IDNO	CONC
1	3.967	6442318	E		73.7988
2	9.398	2122664			24.3132
3	18.943	165531			1.896
TOTAL					8738512

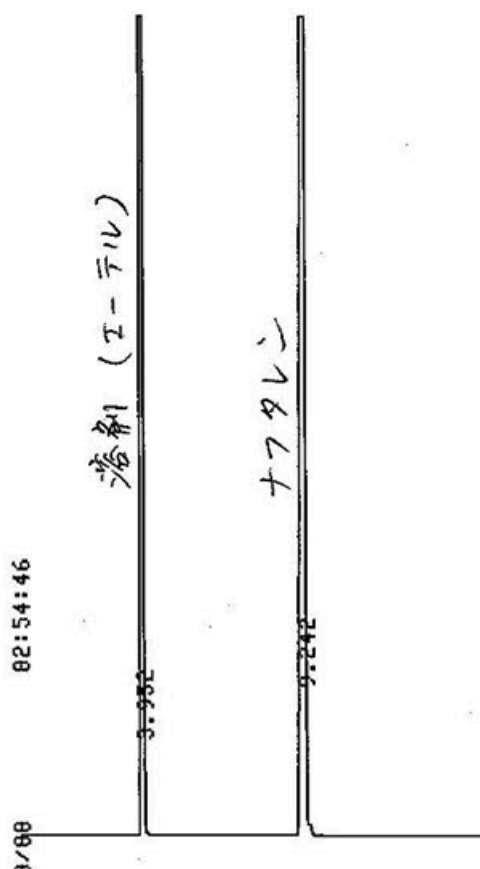
昇華付着結晶



PKNO	TIME	AREA	MK	IDNO	CONC
1	3.95	6171126	E		86.7451
2	9.295	938368	V		13.1902
3	9.485	4687			0.8648
TOTAL					7114892

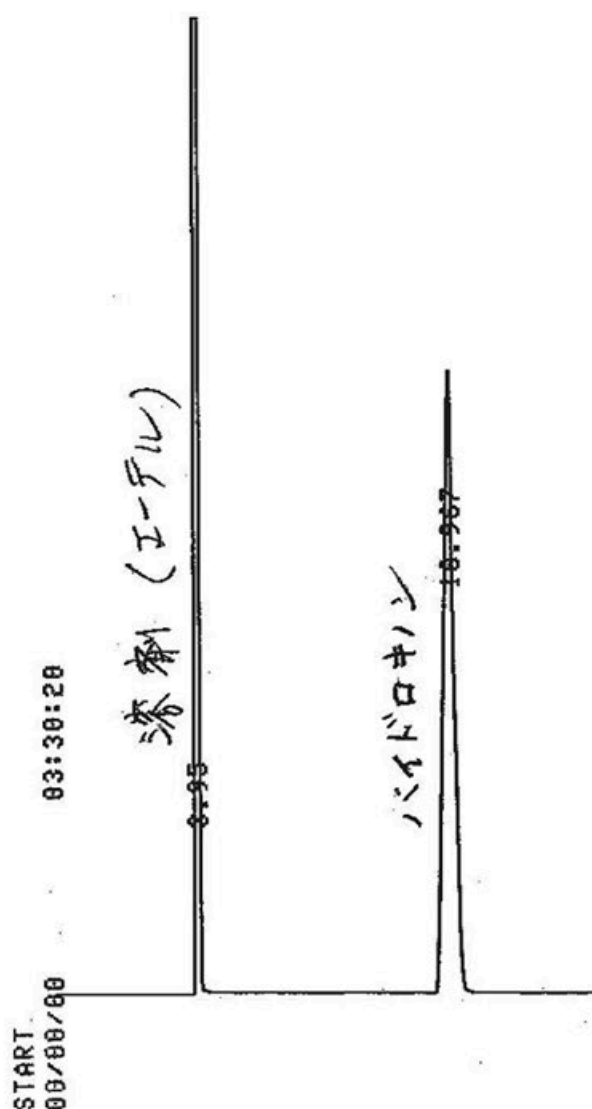
受器回収結晶

SLOPE 5425.19
 MIN.AREA 3800
 STOP.TM 15
 SPEED 5
 FORMAT\$ 0
 IS.WT 1



PKNO	TIME	AREA	MK	IDNO	CONC
1	3.952	3593296	E		83.6852
2	9.242	735786			16.9948
TOTAL					4329082

残留物



PKNO	TIME	AREA	MK	IDNO	CONC
1	3.95	6172016	E		93.8828
2	18.967	487764			6.1972
TOTAL					6579780